

から選べ。ただし、ゲート(G)-ソース(S)間電圧 V_{GS} 及びドレイン(D)電流 I_D は図1の矢印で示した方向を正(+)とする。

- (1) 図1に示す図記号の電界効果トランジスタは **A** チャンネルで、**B** 形である。
 (2) (1)の伝達特性の概略図を、 V_{GS} [V] と I_D [A] 間の特性で示すと **C** である。

A	B	C
1 P	MOS(絶縁ゲート)	図3
2 P	接合	図2
3 N	MOS(絶縁ゲート)	図3
4 N	接合	図3
5 N	MOS(絶縁ゲート)	図2

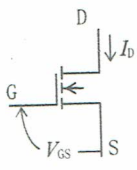


図1

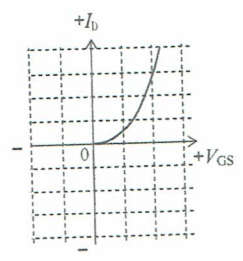


図2

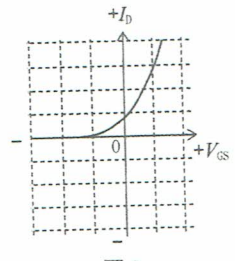
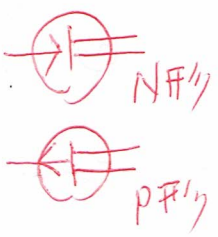


図3

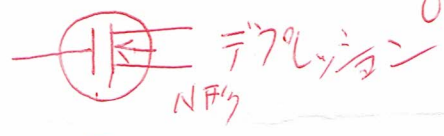
トランジスタ ← バイポーラ (トランジスタ BEC)
 エンポーラ FET 電界効果トランジスタ

FET ← 接合形 ~~P-N~~ P-N 加直接
 MOS形 酸化物膜 ← デプロレション
 インハンスメント

接合形



MOS



0Vでも電流が流れる



インハンスメント 0V 電流が流れない